

1 产品特点

- ◆ 单层芯片瓷介电容器体积小、精度高、结构坚固、性能稳定。
- ◆ 表面采用金电极，适合金丝、金带等微组装工艺。
- ◆ 两只电容串联成一只产品，插入损耗低而自谐振频率极高。



2 产品应用

广泛应用于光通信、无线通信等电子设备中，在高频、微波电路中起隔直、旁路、滤波、耦合、调谐、匹配等作用。

3 订货示例

SG	2	25	2X1	2A	101M	C	C	01
产品型号	电极结构	外形尺寸代码	温度特性(系数)	额定电压	标称容量及容差	电极材料	包装形式	产品设计
表 1	表 2	表 3	表 4	表 5	表 6、7	表 8	表 9	表 10

表 1 产品型号	表 2 电极结构	外形图
SG: 双片串联单层芯片瓷介电容器	2: 2 电极	

外形尺寸代码	W	Lmax	G (典型值)	T
10	0.254 ± 0.076	0.762	0.127	0.07 ~ 0.40
15	0.381 ± 0.076	1.016	0.203	
20	0.508 ± 0.076	1.270	0.254	
25	0.635 ± 0.076	2.032	0.508	
30	0.762 ± 0.076	2.032	0.508	
35	0.889 ± 0.127	2.032	0.508	
40	1.016 ± 0.127	2.032	0.508	
50	1.270 ± 0.127	2.032	0.508	

注：参数 G 设定为典型值，不进行考核。

表 4 温度特性 (系数)	工作温度范围	表 5 额定电压	
AG、CG、UK VL、KL、DM	-55°C ~ 125°C	1C	16V
2X1	-55°C ~ 125°C	1E	25V
2F2	-55°C ~ 85°C	1H	50V
2F4	-25°C ~ 85°C	1J	63V
X7R、X7S	-55°C ~ 125°C	2A	100V

表 6 标称电容量

采用三位标法，前两位代表电容量的有效值，第三位代表有效值后 0 的个数，单位为 pF，例如：101=100pF；10pF 以下的，用 R 表示小数点，例如：3R9=3.9pF。

表 7 容差

标称电容量 < 10pF		标称电容量 ≥ 10pF			
代码	允许偏差 (pF)	代码	允许偏差 (%)	代码	允许偏差 (%)
A	±0.05	F	±1	L	±15
B	±0.1	G	±2	M	±20
C	±0.25	J	±5	S	-20 ~ +50
D	±0.50	K	±10	Z	-20 ~ +80

表 8 电极材料

表 9 包装形式

表 10 产品设计

P: TiW/Au	C: 华夫盒包装 E: 蓝膜包装, 7.87 寸蓝膜, 无扩晶环 F: 蓝膜包装, 带 6 寸扩晶环	产品设计代码: 默认空缺; 当用户特殊要求或产品设计改进等需对同一型号规格产品加以区分时, 在产品命名规则最后增加代码, 采用两位数字表示, 从“01”开始按顺序排行。
T: TiW/Ni/Au		
C: NiCr/Au		
S: 特殊电极		

4 SG 双片串联 1 类瓷 / 2 类瓷电容量范围

外形尺寸 代码	额定电压	温度特性	电容量范围								单位 pF
			AG	CG	UK	VL	KL	DM	2X1	2F2	
10	25V	最小	0.02	0.04	0.25	0.39	0.85	1.1	2.2	18	
		最大	0.07	0.38	0.52	1.1	1.8	2.2	19	46	
	50V	最小	0.02	0.03	0.23	0.36	0.79	0.99	2.0	17	
		最大	0.05	0.30	0.50	1.1	1.7	2.1	15	37	
15	25V	最小	0.04	0.07	0.51	0.79	1.7	2.2	4.4	37	
		最大	0.11	0.66	0.88	1.9	3.0	3.7	33	80	
	50V	最小	0.03	0.05	0.35	0.54	1.2	1.5	3.0	26	
		最大	0.09	0.51	0.85	1.9	2.9	3.6	25	62	
20	25V	最小	0.07	0.13	0.91	1.4	3.1	3.8	7.8	66	
		最大	0.18	1.0	1.4	3.0	4.6	5.8	52	130	
	50V	最小	0.04	0.08	0.55	0.84	1.9	2.3	4.7	40	
		最大	0.14	0.79	1.3	2.9	4.5	5.6	40	97	
25	50V	最小	0.07	0.13	0.91	1.4	3.1	3.9	7.9	67	
		最大	0.25	1.4	2.4	5.2	8.0	10	71	170	
30	50V	最小	0.08	0.14	0.98	1.5	3.3	4.1	8.5	71	
		最大	0.29	1.7	2.8	6.2	9.5	12	84	210	
35	50V	最小	0.09	0.15	1.1	1.7	3.7	4.6	9.3	79	
		最大	0.36	2.1	3.4	7.5	12	14	100	250	
40	50V	最小	0.10	0.18	1.3	1.9	4.2	5.3	11	91	
		最大	0.40	2.3	3.9	8.5	13	16	120	280	
50	50V	最小	0.13	0.23	1.6	2.5	5.4	6.8	14	120	
		最大	0.49	2.8	4.7	10	16	20	140	350	

5 SG 双片串联 3 类瓷电容量范围

外形尺寸代码	额定电压	电容量范围		单位 pF
		温度特性	X7R、X7S	
10	25V	最小	32	
		最大	120	
15	25V	最小	54	
		最大	200	
20	25V	最小	92	
		最大	310	
25	25V	最小	170	
		最大	550	
30	25V	最小	210	
		最大	650	
35	25V	最小	230	
		最大	790	
40	25V	最小	270	
		最大	890	
50	25V	最小	340	
		最大	1100	